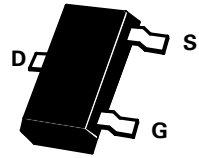


# SOT23 P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

ISSUE 3 - JANUARY 1996

## BS250F



SOT23

PARTMARKING DETAIL – MX

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Drain-Source Voltage	$V_{DS}$	-45	V
Continuous Drain Current at $T_{amb}=25^{\circ}C$	$I_D$	-90	mA
Pulsed Drain Current	$I_{DM}$	-1.6	A
Gate Source Voltage	$V_{GS}$	$\pm 20$	V
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	$P_{tot}$	330	mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

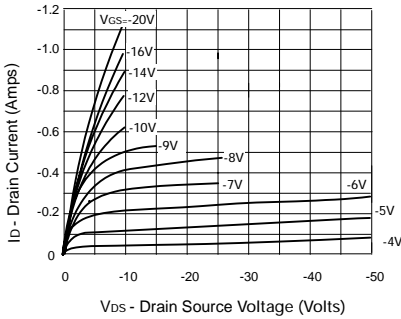
PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Drain-Source Breakdown Voltage	$BV_{DSS}$	-45	-70		V	$I_D = -100\mu A, V_{GS} = 0V$
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	-1		-3.5	V	$I_D = -1mA, V_{DS} = V_{GS}$
Gate-Body Leakage	$I_{GSS}$			-20	nA	$V_{GS} = -15V, V_{DS} = 0V$
Zero Gate Voltage Drain Current	$I_{DSS}$			-0.5	$\mu A$	$V_{DS} = -25V, V_{GS} = 0V$
Static Drain-Source On-State Resistance (1)	$R_{DS(on)}$		9	14	$\Omega$	$V_{GS} = -10V, I_D = -200mA$
Forward Transconductance (1)(2)	$g_{fs}$		90		mS	$V_{DS} = -10V, I_D = -200mA$
Input Capacitance (2)	$C_{iss}$		25		pF	$V_{DS} = -10V, V_{GS} = 0V, f = 1MHz$
Turn-On Delay Time (2)(3)	$t_{d(on)}$			10	ns	$V_{DD} \approx -25V, I_D = -200mA$
Rise Time (2)(3)	$t_r$			10	ns	
Turn-Off Delay Time (2)(3)	$t_{d(off)}$			10	ns	
Fall Time (2)(3)	$t_f$			10	ns	

(1) Measured under pulsed conditions. Width=300 $\mu s$ . Duty cycle  $\leq 2\%$  (2) Sample test.

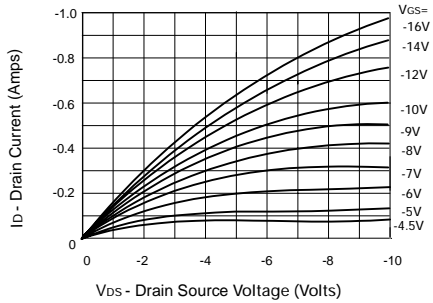
(3) Switching times measured with 50 $\Omega$  source impedance and <5ns rise time on a pulse generator  
Spice parameter data is available upon request for this device

# BS250F

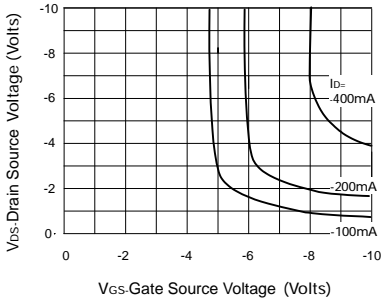
## TYPICAL CHARACTERISTICS



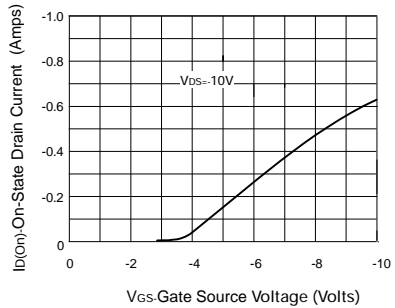
**Output Characteristics**



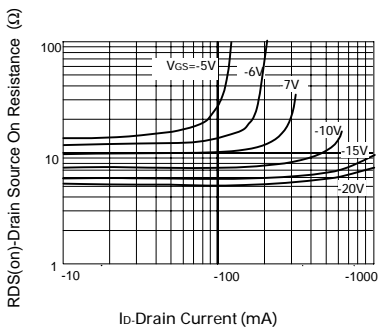
**Saturation Characteristics**



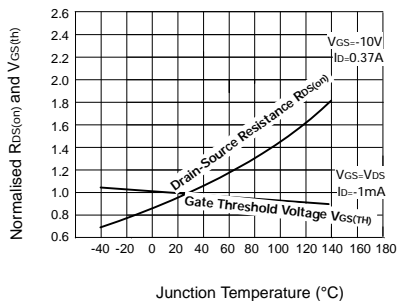
**Voltage Saturation Characteristics**



**Transfer Characteristics**

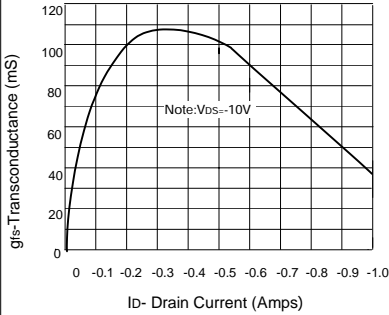


**On-resistance vs Drain Current**

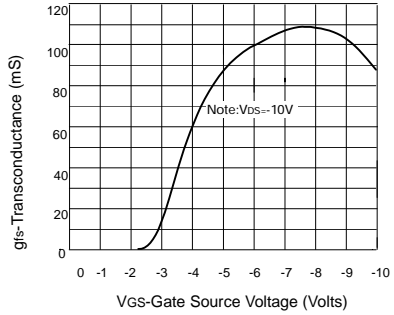


**Normalised  $R_{DS(on)}$  and  $V_{GS(th)}$  vs Temperature**

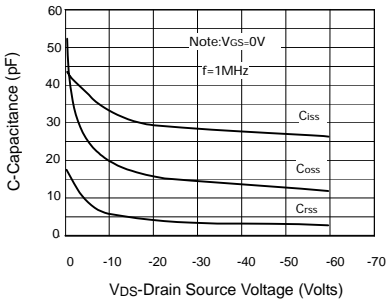
## TYPICAL CHARACTERISTICS



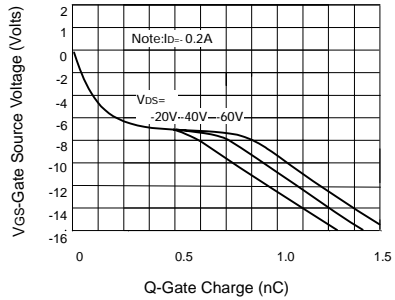
**Transconductance v drain current**



**Transconductance v gate-source voltage**



**Capacitance v drain-source voltage**



**Gate charge v gate-source voltage**

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)